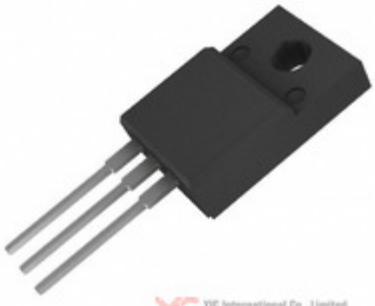

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHF6N65E-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 6A TO220FP</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHF6N65E-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHF6N65E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 6A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	8 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	SIHF6N65E-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	820pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 7A (Tc) 31W (Tc) Through Hole TO-220
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

SIHF6N65E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHF6N65E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHF6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHF6N65E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHF720S</b> VB SIHF720S VB</p>	 <p><b>SIHF710</b> VB SIHF710 VB</p>	 <p><b>SIHF6N40D-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 6A TO-220 FPAK</p>	 <p><b>SIHF6N65E</b> vishay SIHF6N65E vishay</p>
 <p><b>SIHF6N40D-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 6A TO-220 FPAK</p>	 <p><b>SIHF720</b> VB SIHF720 VB</p>	 <p><b>SIHF6N40D</b> VB SIHF6N40D VB</p>	 <p><b>SIHF710S</b> V SIHF710S V</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHF6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHF6N65E-GE3 Datenblatt	SIHF6N65E-GE3-Datenblätter	SIHF6N65E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHF6N65E-GE3
SIHF6N65E-GE3 Electronic	SIHF6N65E-GE3-Komponenten	SIHF6N65E-GE3-Verteiler	SIHF6N65E-GE3-Bild	SIHF6N65E-GE3-Teil
SIHF6N65E-GE3 Preis	SIHF6N65E-GE3 Hersteller	SIHF6N65E-GE3 Bild	SIHF6N65E-GE3 Aktie	SIHF6N65E-GE3 Inventar
SIHF6N65E-GE3 Neu	SIHF6N65E-GE3 Original	SIHF6N65E-GE3 garantiert	SIHF6N65E-GE3 RFQ	SIHF6N65E-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited